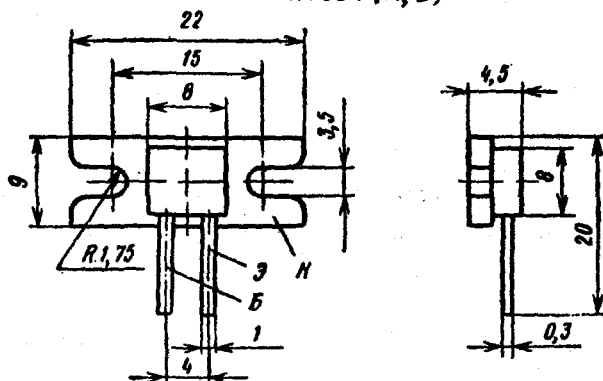


КТ807 (А, Б), КТ807 (АМ, БМ)

Транзисторы кремниевые мезопланарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в генераторах кадровой и строчной разверток, усилителях низкой частоты, источниках вторичного электропитания. Выпускаются в металлопластмассовом (КТ807А, КТ807Б) и пластмассовом (КТ807АМ, КТ807БМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзисторов КТ807А, КТ807Б не более 2,5 г, КТ807АМ, КТ807БМ — не более 1 г.

КТ807 (А, Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кв} = 5 \text{ В}$, $I_{к} = 0,5 \text{ А}$:

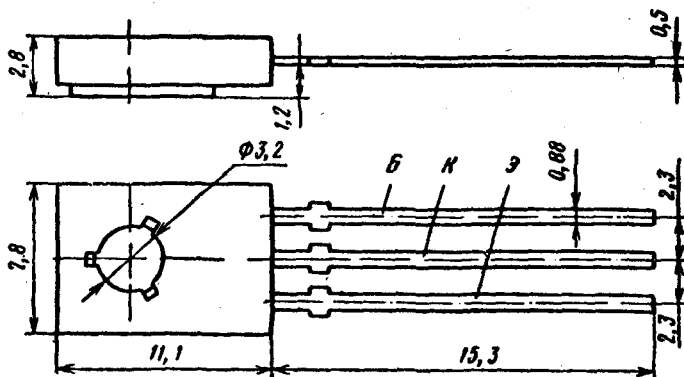
$T = +25^\circ \text{ С}$:

КТ807А, КТ807АМ 15...45
 КТ807Б, КТ807БМ 30...100

$T = +85^\circ \text{ С}$:

КТ807А, КТ807АМ 20...60
 КТ807Б, КТ807БМ 45...150

КТ807 (АМ, БМ)



Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ, не менее	5 МГц
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{к} = 0,5 \text{ А}$, $I_{б} = 0,1 \text{ А}$, не более	В
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{кв} = 100 \text{ В}$, $R_{бэ} = 10 \text{ Ом}$, не более:	
$T = +25^\circ \text{ С}$	мА
$T = +85^\circ \text{ С}$	мА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 4 \text{ В}$, не более	мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{бэ} = 10 \text{ Ом}$ или $R_{бэ} = 1 \text{ КОм}$ и запирающем напряжении эмиттер — база 0,5 В	100 В
Импульсное напряжение коллектор — эмиттер	120 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	4 В
Постоянный ток коллектора	0,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_u < 1 \text{ мс}$, и $Q \geq 2$	1,5 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T = -40 \dots +70^\circ \text{ С}$	10 Вт
Тепловое сопротивление переход — корпус	8° С/Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	$+150^\circ \text{ С}$
Температура окружающей среды	$-40 \dots +85^\circ \text{ С}$

¹ При $T > +70^\circ \text{ С}$ мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, \text{ макс. Вт}} = (150 - T) / R_{T(n-k)}$$

Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба и пайки вывода не менее 5 мм. Радиус изгиба 1,5...2 мм. Пайка выводов должна осуществляться при температуре не более $+250^\circ \text{ С}$ в течение не более 3 с.